



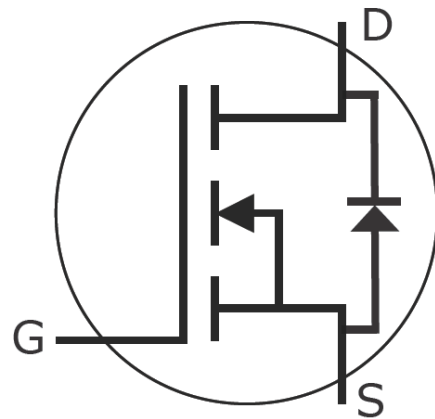
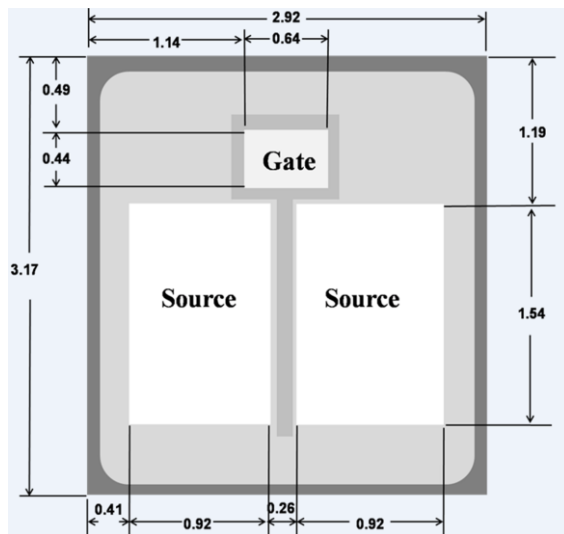
产品编号: H3M45170L

N 沟道 SiC 功率 MOSFET

$V_{DS} = 1700\text{ V}$

$R_{DS(on)} = 45\text{ m}\Omega$

芯片尺寸 (mm)



机械参数

参数	典型值	单位
芯片尺寸	5.1×5.4	mm
栅极压块窗口	0.64×0.44	mm
源极压块窗口	1.98×3.75	mm
芯片厚度	360±50	μm
栅极金属化 (Al)	4	μm
源极金属化 (Al)	4	μm
漏极金属化 (Ni/Ag)	0.4/1.2	μm

## 电参数 (除特别申明外 $T_j=25^\circ\text{C}$ )

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
源漏击穿电压	$V_{(BR)DSS}$	1700	/	/	V	$V_{GS}=0V, I_{DS}=100\mu A$
栅阈值电压	$V_{GS(th)}$	2.0	2.5	/	V	$V_{DS}=10V, I_{DS}=18mA$
零栅压漏极电流	$I_{DSS}$	/	1	100	$\mu A$	$V_{DS}=1700V, V_{GS}=0V$
栅源漏电流	$I_{GSS}$	/	10	250	nA	$V_{DS}=0V, V_{GS}=20V/-10V$
通态源漏电阻	$R_{DS(on)}$	/	45	70	$m\Omega$	$V_{GS}=20V, I_D=50A$